

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 須原理彦 副委員長 藤代博記

幹事 大石敏之・岩田達哉 幹事補佐 小谷淳二・堤 卓也

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 武山真弓 副委員長 中村雄一

幹事 中澤日出樹 幹事補佐 木村康男・寺迫智昭・廣瀬文彦

★レーザ・量子エレクトロニクス研究会 (LQE)

専門委員長 有賀 博 副委員長 八坂 洋

幹事 川北泰雅・永井正也 幹事補佐 瀬川 徹

日時 11月21日(木) 10:10~16:30

22日(金) 9:40~15:20

会場 静岡大学浜松キャンパス(浜松市中区城北3-5-1. JR東海:浜松駅前北口バスターミナル15, 16番乗り場から遠鉄バス全路線「静岡大学」下車(約20分). <http://www.shizuoka.ac.jp/campuslife/campus/hamamatsu/index.html>)

議題 窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般

21日午前

1. ZnOのALD成長での平坦薄膜成長条件の調査 ○山本 燎・加納寛人・中村篤志・居波 渉(静岡大)
2. ミストCVD法によりc面サファイア基板上に高温下で成長したZnO結晶の発光特性
○大橋紘誠・藤原健八・山本幹大・原 和彦(静岡大)・酒井 優(山梨大)・光野徹也(静岡大)
3. 化学溶液析出法によって種々のTCOシード層に成長したZnOナノロッドの構造及びフォトルミネッセンス特性
濱本昂大・○寺迫智昭(愛媛大)・矢木正和(香川高専)・古林 寛・山本哲也(高知工科大)
4. 化学溶液析出法による極薄GZO薄膜シード層上へのZnOナノロッドと構造及び光学特性 ○寺迫智昭・濱本昂大・山田健太・甲田真一郎(愛媛大)・矢木正和(香川高専)・古林 寛・山本哲也(高知工科大)

21日午後(12:20~)

5. 電気化学的な処理を用いた酸化亜鉛光触媒の特性改善 ○安部功二・大竹徳人(名工大)
6. Ga₂O₃ショットキーバリアダイオードを用いたマイクロ波-DC変換動作の実証と負荷抵抗依存性
○橋川 誠・浦田幸佑・竹ノ畑拓海・網代康佑・大島孝仁・大石敏之(佐賀大)
7. リセス深さによるノーマリーオフ型Ga_NMOSFETの短チャンネル効果改善
○加藤大望・梶原瑛祐・向井 章・大野浩志・新留 彩・田島純平・彦坂年輝・蔵口雅彦・布上真也(東芝)
8. ICP-RIEによって作製されたGa_Nトレンチ側壁のダメージ評価
○山田真嗣・櫻井秀樹(名大/アルバック)・長田大和・中村敏幸・上村隆一郎(アルバック)・須田 淳・加地徹(名大)
9. ALDにより成膜したSiO₂/Al₂O₃2層絶縁膜を用いたAlGa_N/Ga_NMIS-HEMTのデバイス特性評価
○横井駿一・古岡啓太・久保俊晴・江川孝志(名工大)
10. 両極性同時成長を用いたGa_N-QPM結晶の作製及びSHGに向けた光学特性評価
○松久快生・小林佑斗・石原弘基・杉浦真子・杉田篤史・井上 翼・中野貴之(静岡大)
11. AlGa_Nを井戸層に用いた電子線励起レーザ ○櫻木勇介・安江信次・手良村昌平・荻野雄矢・田中隼也・岩山章・岩谷素顕・上山 智・竹内哲也・赤崎 勇(名城大)・三宅秀人(三重大)
12. MOCVD法によるGa_N, GaIn_N上への厚膜AlIn_N膜のエピタキシャル成長
○山中瑞樹・三好実人・江川孝志(名工大)・岡田成仁・只友一行(山口大)・竹内哲也(名城大)
13. Ga_Nに格子整合する組成近傍の四元混晶AlGaIn_Nエピタキシャル膜の成長と結晶及び光学特性評価
○原田紘希・三好実人・江川孝志(名工大)・竹内哲也(名城大)
14. AlIn_N/Ga_N多層膜反射鏡を有するGa_N系面発光レーザーの偏波特性 ○小田 薫・飯田涼介・岩山 章・清原一樹・竹内哲也・上山 智・岩谷素顕(名城大)・赤崎 勇(名城大/名大)
15. 組成傾斜界面を有するn型導電性AlIn_N/Ga_NDBRを用いたGa_N系VCSEL
○上島佑介・飯田涼介・岩山 章・竹内哲也・上山 智・岩谷素顕(名城大)・赤崎 勇(名城大/名大)

22日午前

1. 蒸着Sn膜の直接硫化による二硫化錫薄膜の結晶性評価 ○田村優樹・中村篤志(静岡大)
2. 有機太陽電池用反射防止ナノテクスチャに関する実験検討
○平賀健太・久保田 繁・鹿又健作・有馬ボシールアハンマド(山形大)・水野 潤(早大)・廣瀬文彦(山形大)
3. エレクトロスピンニング法を用いたポリウレタンファイバーマットのコンポジット化

○森 拓海・中村篤志（静岡大）

4. pH センサにおける電極表面特異性の評価 ○新澤亮介・中村篤志（静岡大）

5. 非酵素グルコースセンサの作製 ○丹羽貴大・中村篤志（静岡大）

6. 脳深部光刺激用 LED プローブの実現に向けた針型構造の作製

○中山雄晟・安永弘樹（豊橋技科大）・大澤匡弘・稲波千尋（名市大）・関口寛人（豊橋技科大/JST さきがけ）

22 日午後（12：45～）

7. DC スパッタ AlN テンプレートを用いた UVLED の進展

○最上耀介（理研/埼玉大）・大澤篤史・尾崎一人・谷岡千丈・前岡淳史（SCREEN）・糸数雄吏（理研/埼玉大）・定 昌史・前田哲利（理研）・矢口裕之（埼玉大）・平山秀樹（理研）

8. 微傾斜 AlN(0001)面上への GaN 極薄膜量子井戸の作製と光学特性 ○船戸 充・小林敬嗣・川上養一（京大）

9. UV-B 領域 AlGaIn 活性層の光学利得と内部ロスの転位密度依存性 ○田中隼也・川瀬雄太（名城大）・佐藤恒輔（旭化成/名城大）・安江信次・手良村昌平・荻野雄矢（名城大）・岩山 章（名城大/三重大）・岩谷素顕・竹内哲也・上山 智（名城大）・赤崎 勇（名城大/名大）・三宅秀人（三重大）

10. Na フラックス法で作製した GaN 基板の光学特性

○高橋佑知（金沢工大）・佐藤 隆・三好直哉・村上明繁・皿山正二（サイオクス）・山口敦史（金沢工大）

11. InGaIn 量子井戸における Mobility Edge の見積もり方法に関する理論的・実験的研究

○藤田貴志・坂井繁太・池田優真・山口敦史（金沢工大）・草薙 進・蟹谷裕也・工藤喜弘・富谷茂隆（ソニー）

12. 光音響・発光同時計測による InGaIn 量子井戸の内部量子効率の推定

○森 恵人・高橋佑知・山口敦史（金沢工大）・草薙 進・蟹谷裕也・工藤喜弘・富谷茂隆（ソニー）

13. 光熱偏向分光による III-V 族窒化物の評価 角谷正友（物質・材料研究機構）

☆ED 研究会

【問合先】

東脇正高（NICT）

TEL [042] 327-6092, FAX [042] 327-5527

E-mail : mhigashi@nict.go.jp

大石敏之（佐賀大）

TEL [0952] 28-8642

E-mail : oishi104@cc.saga-u.ac.jp

☆CPM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11 月 26 日（火） 機械振興会館 [締切済] テーマ：エネルギー技術，半導体電力変換，電池，電気化学デバイス，材料，一般

【問合先】

寺迫智昭（愛媛大）

TEL [089] 927-9789, FAX [089] 927-9790

E-mail : terasako.tomoaki.mz@ehime-u.ac.jp

☆LQE 研究会

【問合先】

川北泰雅（古河電工）

TEL [045] 311-1219

E-mail : yasumasa.kawakita@furukawaelectric.com

永井正也（阪大大学院）

TEL [06] 6850-6507

E-mail : mnagai@mp.es.osaka-u.ac.jp

◎LQE 研究会ホームページ

<http://www.ieice.org/~lqe/jpn/welcome.html>

◎LQE 研究会では平成 18 年度より「LQE 奨励賞」を設けました。対象は発表年度の 4 月 1 日時点で 32 歳以下の若手研究者（学生を含む）です。積極的に御投稿下さい。